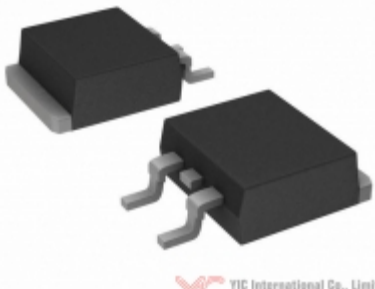











	<h2 style="color: #E67E22;">IPB027N10N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB027N10N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 120A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB027N10N3GATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 738 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB027N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	738 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 275µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB027N10N3GATMA1 ist neu im Original, Suche IPB027N10N3GATMA1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB027N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB027N10N3GATMA1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB027N10N3G INFINEO IPB027N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB026N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 25A TO263-3</p>	 <p>IPB027N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK-3</p>	 <p>IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON</p>
 <p>IPB029N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB029N06N3G INFINEO IPB029N06N3G INFINEO</p>	 <p>IPB027N10N3 G INFINEON IPB027N10N3 G INFINEON</p>	 <p>IPB029N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) IPB029N06N3 G Infineon Technologies</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ⊕ IPB011N04NG | ↔ IPB014N06N | ⇒ IPB015N04LG | D IPB015N04N | ⇒ IPB015N04NG |
| ⊖ IPB016N06L3 | ⊕ IPB016N06L3G | D IPB017N06N3G | ⇒ IPB019N06L3 | ⇒ IPB019N06L3G |
| ⊕ IPB019N08N3 | ⊖ IPB019N08N3G | ⊕ IPB020N04NG | ↔ IPB020NE7N3G | ⇒ IPB021N04N |
| D IPB021N04NG | ⊕ IPB021N06N3G | ⊖ IPB022N04L | ⊕ IPB022N04LG | ⇒ IPB023N04NG |
| ⇒ IPB023N06N3G | ↔ IPB025N08N3G | ⊕ IPB025N10N3G | ⊖ IPB026N06N | ⇒ IPB027N10N3G |
| ↔ IPB029N06N3G | ⇒ IPB031NE7N3G | D IPB034N03LG | ⊕ IPB034N06L3G | ⊖ IPB034N06N3G |
| ⊕ IPB035N08N3G | D IPB036N12N3G | ⇒ IPB037N06N3G | ↔ IPB038N08N3G | ⇒ IPB039N04LG |
| ⊖ IPB039N10N3G | ⊕ IPB03N03LA | ↔ IPB03N03LAG | ⇒ IPB03N03LBG | ⇒ IPB041N04NG |
| ⊕ IPB042N03LG | ⊖ IPB042N10N3G | ⊕ IPB048N06LG | D IPB049N06L3G | ⇒ IPB049NE7N3G |
| ↔ IPB04CN10NG | ⊕ IPB04CNE8NG | ⊖ IPB04N03LA | ⊕ IPB04N03LAG | ⇒ IPB04N03LBG |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited